

**Fondamenti di Elettronica - Ingegneria Elettronica – a.a. 2010/11**  
**Terzo appello – 27 gennaio 2012**  
**Traccia di soluzione**

**Esercizio 1**

**a) valore della resistenza  $R_s$  per garantire una corrente  $I=1mA$**

Poiché il MOS è percorso da una corrente di 1mA, il drain si trova a

$$V_D = I \cdot R_D = +0.5V$$

Il gate si trova a +2V, poiché non scorre corrente in  $R_G$ ; si verifica, quindi, che essendo  $V_{GD}=+1.5V$ , il pMOS opera effettivamente in saturazione.

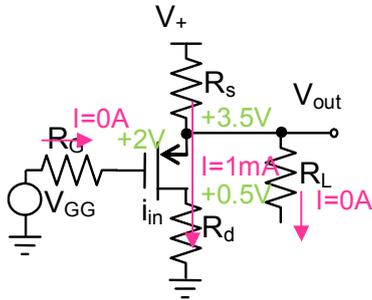
$C_L$  è un circuito aperto e  $i_{in}$  è spento, pertanto abbiamo

$$V_{GS} = -\sqrt{\frac{I}{|k_p|}} + V_{Tp} = -1.5V$$

da cui si ricava  $V_S = V_{GG} - V_{GS} = +3.5V$  e, pertanto:

$$R_s = \frac{V^+ - V_S}{I} = 2.5k\Omega$$

La completa polarizzazione del circuito è indicata in figura.



Nella soluzione del tema d'esame non sarebbe accettabile indicare i soli valori di polarizzazione sul circuito senza specificare i calcoli eseguiti per giungere a tali valori.

La transconduttanza vale

$$g_{m_p} = 2k_p (V_{GS_p} - V_{Tp}) = 2mA/V$$

**b) espressione e valore del trasferimento  $V_{out}/I_{in}$  a bassa frequenza**

A bassa frequenza  $C_L$  è un circuito aperto.

$$v_{out} = \frac{R_s}{\frac{1}{g_{m_p}} + R_s} (-R_G i_{in})$$

Pertanto il trasferimento  $V_{out}/I_{in}$  a bassa frequenza risulterà pari a

$$\frac{v_{out}}{i_{in}} = -\frac{R_G R_s}{\frac{1}{g_{m_p}} + R_s} = -8.3k\Omega$$

**c) diagramma di Bode del modulo del trasferimento  $V_{out}/I_{in}$**

La capacità  $C_L$  introduce un polo nel circuito con costante di tempo pari a

$$\tau_p = C_L \left( R_L + R_s // \frac{1}{g_{m_p}} \right) = 10.42\mu s \rightarrow f_p = 15.3kHz$$

La capacità  $C_L$  introduce anche uno zero nel circuito, poiché alla pulsazione complessa  $s$  che soddisfa la seguente relazione

$$Z_{eq}(s) = R_L + \frac{1}{sC_L}$$

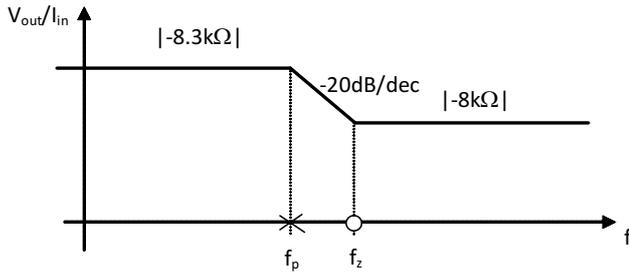
l'uscita si trova direttamente cortocircuitata a massa:

$$\tau_z = C_L R_L = 10\mu s \rightarrow f_z = 15.9kHz$$

Il trasferimento ad alta frequenza, quando la capacità  $C_L$  si comporta come un cortocircuito, è dato da

$$\frac{v_{out}}{i_{in}} = -\frac{R_G(R_s // R_L)}{\frac{1}{g_{m_p}} + (R_s // R_L)} = -8k\Omega$$

Il diagramma di Bode del modulo del trasferimento sara' quello mostrato in figura:



#### d) massima ampiezza di $i_{in}$ , sinusoidale, per essere definito "piccolo segnale"

La condizione di piccolo segnale richiede che

$$v_{gs} \ll 2|V_{GS_p} - V_{Tp}|$$

A 1kHz la capacita' e' assimilabile ad un circuito aperto, pertanto

$$v_{gs} = -i_{in} R_G \frac{\frac{1}{g_{m_p}}}{\frac{1}{g_{m_p}} + R_s}$$

Pertanto la condizione limite sull'ampiezza della corrente di ingresso diviene

$$i_{in} \ll 1.2mA$$

Tuttavia con tale corrente, prendendo il valore limite, si avrebbe una tensione di gate tale da spegnere il MOSFET o da farlo uscire dalla zona di saturazione. Per garantire l'accensione del MOSFET, occorre che la tensione complessiva al gate (somma di segnale e polarizzazione) non superi i +5.5V. Questo fa si' che il vincolo sull'ampiezza della corrente in ingresso, considerando la semionda negativa del segnale, sia di 350  $\mu A$ . La richiesta che il transistor non esca dalla zona di saturazione impone che

$$V_{gd} \geq V_{Tp}$$

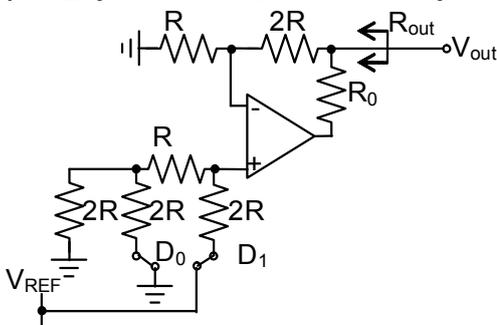
Poiche', tenendo conto di polarizzazione e segnale ed usando l'approssimazione di piccolo segnale, si ha:

$$V_{gd} = V_{GG} - i_{in} R_G - \left[ I R_d - \frac{g_m R_d}{1 + g_m R_s} (-i_{in} R_G) \right],$$

la limitazione sull'ampiezza della corrente in ingresso (considerando la semionda positiva) e' a 171  $\mu A$ . Pertanto la massima ampiezza sara' al di sotto di 171  $\mu A$  cosi' da soddisfare sia l'accensione e la saturazione del transistor, che la condizione di piccolo segnale.

### Esercizio 2

a)  $V_{out}$  quando  $D=D_1 D_0=10$ , nelle ipotesi di amplificatore operazionale ideale.



Con un semplice partitore resistivo possiamo calcolare la tensione al morsetto non invertente che risulta

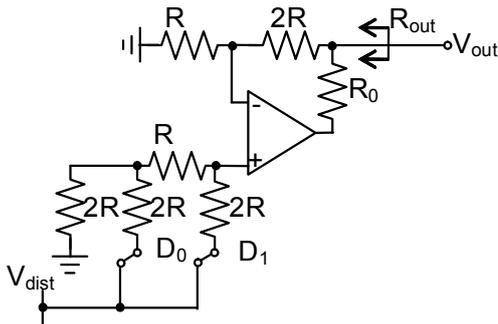
$$v^+ = \frac{2R}{2R + 2R} V_{REF} = \frac{1}{4} V$$

La tensione di uscita vale, quindi:

$$V_{out} = v^+ \left( 1 + \frac{2R}{R} \right) = \frac{3}{4} V$$

**b) massima ampiezza del disturbo in uscita, nelle ipotesi di amplificatore operazionale ideale.**

La condizione piu' gravosa si ha quando la parola digitale in ingresso e'  $D=11$ .



Poiche' il circuito e' lineare, applichiamo il principio di sovrapposizione degli effetti:

$$v_{out,dist} = v_{dist} \left\{ \left( \frac{3R // 2R}{2R + 3R // 2R} \frac{2R}{3R} \right) + \left( \frac{2R}{2R + 2R} \right) \right\} \left( 1 + \frac{2R}{R} \right) = \frac{3}{4} v_{dist} + \frac{3}{2} v_{dist} = 112.5 mV_{pp}$$

**c) espressione e valore della resistenza di uscita  $R_{out}$**

Il circuito e' retroazionato negativamente. La retroazione idealmente tende ad annullare la resistenza  $R_{out}$ . Infatti se, spenti i generatori forzanti (indipendentemente dalla parola digitale applicata in ingresso), applichiamo in uscita un generatore di prova di corrente – per non ostacolare l'effetto della retroazione –, la corrente iniettata si suddividerebbe, in assenza di retroazione tra la resistenza  $R_0$  ed il ramo di retroazione, causando un innalzamento della tensione del nodo di uscita. La frazione di corrente iniettata nel ramo di retroazione provocherebbe un innalzamento della tensione del morsetto meno dell'amplificatore operazionale, che a sua volta provocherebbe un abbassamento della tensione del nodo di uscita dell'amplificatore operazionale, tendendo, quindi, a stabilizzare la tensione del nodo di uscita e, quindi, ad abbassare l'impedenza vista al nodo, rispetto a quella vista in assenza di retroazione.

$$R_{out} = \frac{R_{out}^0}{1 - G_{loop}^*(0)}$$

$$R_{out}^0 = R_0 // (R + 2R) \cong R_0$$

$$G_{loop}^*(0) = - \frac{R}{R + 2R + R_0} A_0 = -3279$$

$$R_{out} = 30 m\Omega$$

**d) tempo necessario perche' la tensione di uscita raggiunga il valore a regime, a meno dell'1%**

Nella transizione della parola digitale in ingresso da  $D=00$  a  $D=11$ , la tensione di uscita transisce da 0 a

$$\frac{9}{4} V_{REF} = \frac{9}{8} V.$$

Assumiamo un comportamento a singolo polo. Dobbiamo calcolare la posizione del polo ad anello chiuso e poi determinare la relazione tra la costante di tempo di tale polo ed il tempo necessario perche' la tensione di uscita raggiunga il valore a regime, a meno dell'1%.

Imponendo

$$0.99 = 1 - \exp(-t/\tau)$$

$$t = 4.6\tau$$

Per il calcolo del polo ad anello chiuso procediamo graficamente:

$$G_{loop}(s) = - \frac{R}{3R + R_0} \frac{A_0}{1 + s\tau_0}$$

da cui

$$G_{and}(s) = -G_{id} G_{loop}(s) = \left( 1 + \frac{2R}{R} \right) \frac{R}{3R + R_0} \frac{A_0}{1 + s\tau_0} \cong \frac{A_0}{1 + s\tau_0}$$

Pur non conoscendo il valore di  $A_0$  e  $\tau_0$  separatamente, possiamo ricavare che il modulo del guadagno d'andata incrocia il modulo del guadagno ideale alla frequenza

$$|G_{and}(j\omega)| = |G_{id}(j\omega)| = 3 \Leftrightarrow f = \frac{1}{3} \frac{A_0}{f_0} = 33 MHz$$

Tale frequenza corrisponde alla frequenza del polo ad anello chiuso del circuito e la costante di tempo risulta pari a

$$\tau = 4.8ns$$

da cui ricaviamo che il tempo necessario perché la tensione di uscita raggiunga il valore a regime, a meno dell'1% è pari a 22.1 ns.

### e) margine di fase

Per calcolare il margine di fase occorre calcolare il guadagno d'anello:

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{1}{1 + s\tau_p} \frac{1}{1 + s\tau_0}$$

$$G_{loop}(0) = -\frac{R}{3R + R_0} A_0 = -3279$$

$$\tau_p = C_x (R // (2R + R_0)) = 1.3ns \rightarrow f_p = 122.5MHz$$

Tracciando il diagramma di Bode del modulo del guadagno d'anello ci rendiamo conto che esso taglia l'asse 0dB a 32.8MHz con pendenza -20 dB/dec. Il criterio di Bode per la stabilità, pertanto, ci garantisce la stabilità. Per determinare il margine di fase procediamo analiticamente:

$$\phi_M = -180^\circ - \underbrace{\text{artg} \frac{f_{0dB}}{f_0}}_{90^\circ} - \underbrace{\text{artg} \frac{f_{0dB}}{f_p}}_{15^\circ} - (-360^\circ) = 75^\circ$$

### Esercizio 3

#### a) $V_{out}$ in assenza del diodo

In assenza del diodo si tratta di un semplice circuito CR. La costante di tempo del circuito è pari a

$$\tau = C \cdot R = 10ms \ll T$$

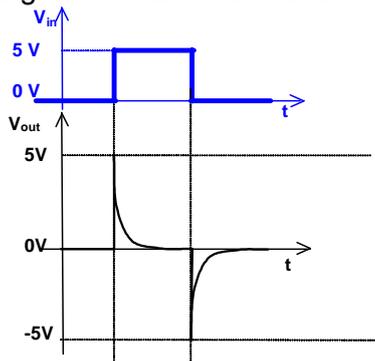
per cui la forma d'onda di uscita va a regime entro la durata del rettangolo. Per determinare l'andamento completo della tensione di uscita calcoliamo il valore dell'uscita a regime e sul fronte. Il valore di tensione cui va a regime la tensione di uscita si ottiene considerando la capacità un circuito aperto, pertanto si avrà una tensione nulla.

Sul fronte la capacità non può variare istantaneamente la tensione ai suoi capi, perciò la tensione di uscita sul fronte risulta

$$\Delta V_{out} |_{fronte} = \Delta V_{in,fronte} = 5V$$

Ovviamente, per la linearità del circuito, il comportamento sull'altro fronte sarà uguale e opposto.

Il grafico della tensione di uscita risulta, quindi, il seguente:



#### b) $V_{out}$ in presenza del diodo

In presenza del diodo, sul fronte positivo non cambia nulla perche' il diodo rimane spento. Sul fronte negativo, invece, il diodo si accende e limita l'escursione della tensione negativa a  $-0.7V$ .

